МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника
Лабораторный практикум №5
по теме: «Усилители»

Работу выполнила: студент группы ИУ7-34Б Ильченко Ева

Работу проверил:

Цель работы

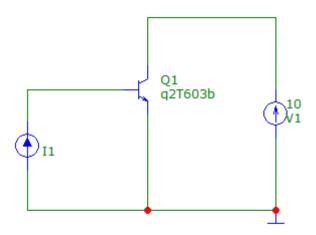
Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Місгосар и знания при исследовании и настройке усилительных, ключевых и логических устройств на биполярных и полевых транзисторах. Приобретение навыков расчета моделей полупроводниковых приборов в программах Multisim и Mathcad по данным, полученным в экспериментальных исследованиях.

В данной работе используется биполярный транзистор q2T603b

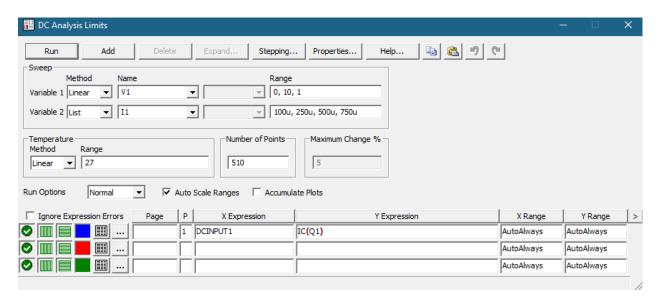
```
.model q2T603b NPN(Is=91.85f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=80 Bf=100 Ne=1.299
+ Ise=410f Ikf=1.033 Xtb=1.5 Br=1.113 Nc=2 Isc=1.265p Ikr=.41 Rc=1.17
+ Rb=12 Cjc=5.646p Mjc=.3443 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=28.89p Mje=.283 Vje=.75
+ Tr=255.1n Tf=389.2p Itf=2.04 Vtf=60 Xtf=2)
```

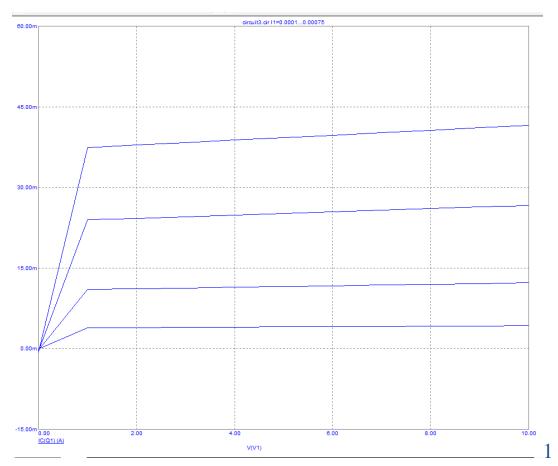
Эксперимент 1

Создадим ВАХ транзистора с общим эммитером:

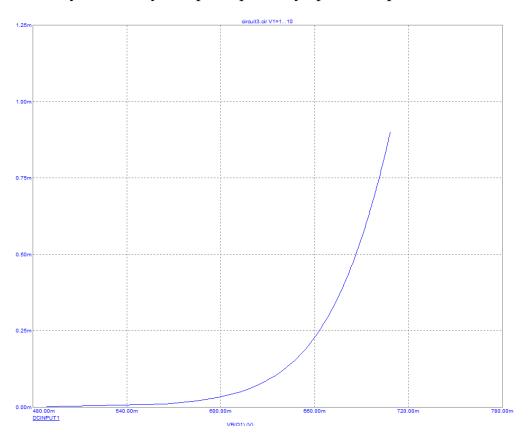


Исследуем характеристику выходного вах-транзистора:





Исследуем входную характеристику транзистора:



- Ік тах Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 300 мА;
- Рк тах Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 0,5 Вт;

Источник: https://eandc.ru/catalog/2t603b/



$$BF := 100$$

$$Ek := 6$$

$$Imax := 0.3$$

$$Ik := 0.15$$

$$Uk := 3$$

$$Rk := \frac{Ek - Uk}{Ik}$$

$$Rk = 20$$

$$Ib := \frac{Ik}{BF}$$

$$Ib = 1.5 \times 10^{-3}$$

Ub := 0.712

Эксперимент 2

Рассчитаем сопротивление базы и коллектора, используя рабочую точку выше:

BF := 100

Ek := 6

Imax := 0.3

Ik := 0.15

Uk := 3

Rk :=
$$\frac{Ek - Uk}{Ik}$$

Rk = 20

Ib := $\frac{Ik}{BF}$

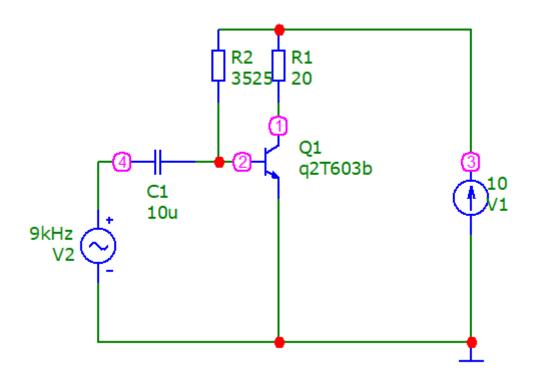
Ib = 1.5 × 10⁻³

Ub := 0.712

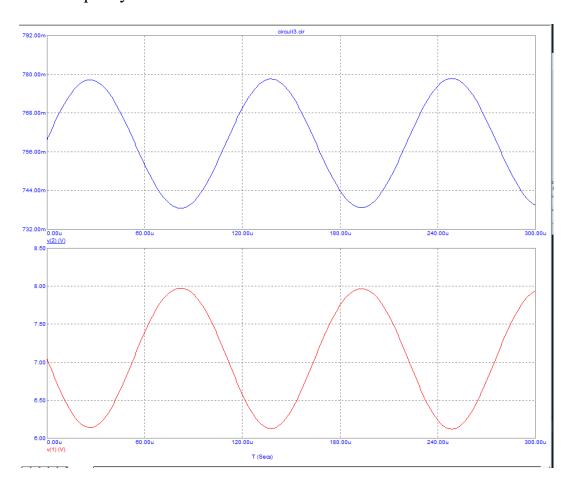
Rb := $\frac{Ek - Ub}{Ib}$

Rb = 3.525 × 10³

Составим схему усилительного каскада, учитывая найденные сопротивления для базы и коллектора из предыдущих расчетов.



Рассмотрим усиление сигнала:



Рассчитаем коэффициент усиления (К):

$$M(Bxoд) = 778-738 = 40m = 0.04B$$

$$M(Выход) = 7.9 - 6.1 = 1.8$$

$$K = 1.8/0.04 = 45$$
 pas

Id в 10 раз больше тока базы $Ib = 1.5 * 10^{-3}$, тогда Id = 0.015.

Тогда
$$R1 + R3 = E_K/I_{\pi} = 6/0.015 = 400$$
,

a
$$R1/R3 = (E_K - U_G)/U_G = (6-0.712)/0.712 = 7.42$$
.

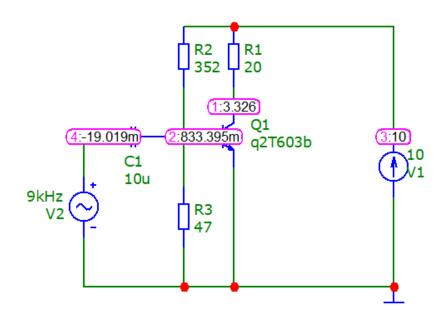
Подставим это выражение в первое уравнение:

$$7.42R3 + R3 = 400.$$

Таким образом, R3 = 47.5.

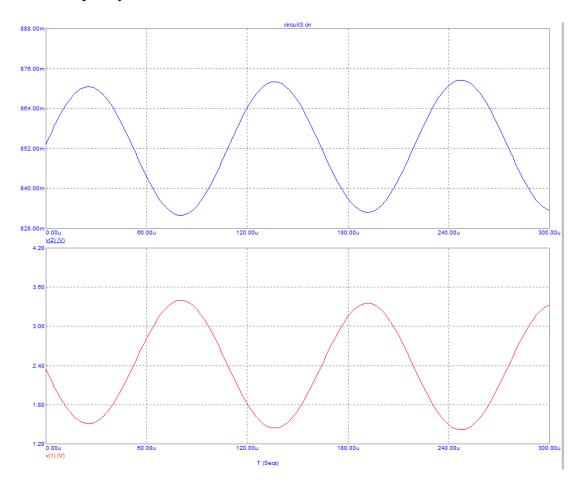
Теперь мы можем найти R1, подставив найденное значение R3 в выражение R1 = 7.42R3.

$$R1 = 7.42 * 47.5 = 352.5$$



Напряжение на коллекторе равно 3.3, что похоже на Ek/2 = 3B.

Рассмотрим усиление сигнала в данной схеме:



Рассчитаем коэффициент усиления (К):

$$M(Bxoд) = 870-830 = 0.04B$$

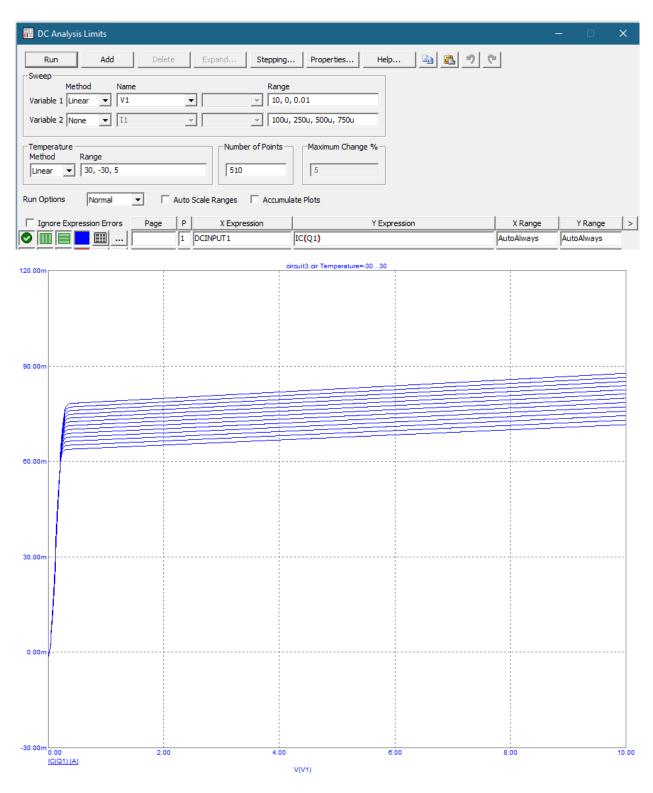
$$M(Выход) = 3.4-1.4= 2$$

$$K = 2/0.04 = 50$$
 pas

Эксперимент 3

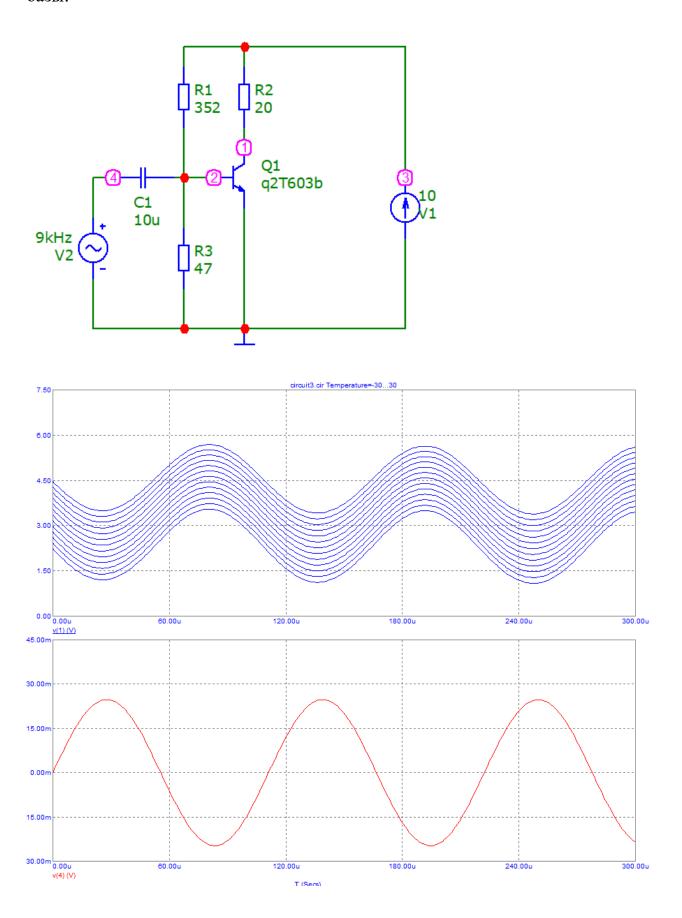
Проведем исследование влияния температуры на входную и выходную ВАХ биполярного транзистора. Для этого используем схему Эксперимента 1, задав изменение температуры от -30 до +30 градусов по Цельсию.

В схеме зададим значение тока для генератора I1, равному току базы рабочей точки (1.5 * 10^{-3})

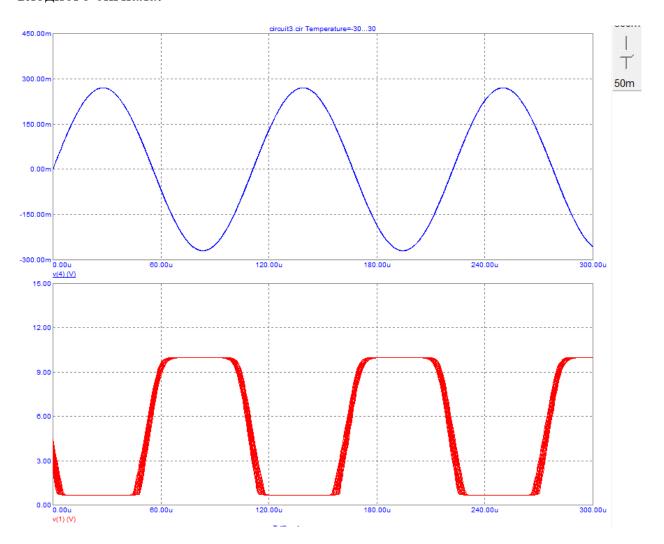


Из графика видно, что увеличение температуры приводит к увеличению тока коллектора.

Изменение выходного сигнала от температуры для схем с стабилизацией ток базы:



Проведем анализ работы усилительного каскада при изменении амплитуды входного сигнала:



При увеличении тока базы (амплитуды входного сигнала) выше определенного значения транзистор входит в режим насыщения, и дальнейшее увеличение тока базы не приводит к увеличению тока коллектора (снижению величины падения напряжения на выходе транзистора), а уменьшение тока коллектора до определенного значения приводит к его полному закрытию (режим отсечки) и падение напряжения на транзисторе становится равно напряжению источника питания.

Вывод

В процессе исследования я ознакомилась с ВАХ биполярного транзистора, а также изучила усилительный каскад и его поведение под воздействием температурных изменений. Этот опыт позволил мне более глубоко понять принципы работы транзисторов и их применение в усилительных схемах, а также оценить влияние температуры на характеристики электронных компонентов.